(9) 日本国特許庁 (JP)

OD 特許出廣公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—194393

60Int. Cl.3 H 05 B 33/14 // C 09 K 11/06 識別記号

庁内整理番号 7254-3K 7215-4H 63公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 12 頁)

砂改良された電力転換効率をもつ有機エレクト ロルミネツセント装置

创特

昭59--58088 童

❷出

昭59(1984) 3 月26日

優先権主張

Ø1983年3月25日發米国(US)

30478938

②発 明 者 スチーブン・アーランド・バン スリク

> アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ

ント・ストリート324

の発 明 者 チヤン・ウオン・タン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14626ロチェスター市バーモン

ト・ドライブ197

イーストマン・コダツク・カン の出 類 人 パニー

> アメリカ合衆国ニューヨーク州 14650ロチェスター市ステート

ストリート343

仍代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外4名

1. (祭明の名称)

改良された魅力転換効率をもつ有機エレク トロルミネツセント袋産

2. (特許請求の範囲)

職次陽極、正孔インジェクション帯域、有機 発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは 1gm を越えないし、および陰極からなり、

とれらの電極のうち少なくとも一方は400 nm 以上の波長をもつ福射線の少なくともBDwを 透過させることができ。かつ

少なくとも9×10 W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネツセント袋童。

ふ(名明の詳細な説明)

本発明は、有機化合物を発光手段とする、暖 気信号に応答して発光するエレクトロルミネン セント袋底に備する。

有機エレクトロルミネッセントを催がそれら の対抗品と十分に対抗しりるものとなるために は、対抗しりるコストにかいてそれらの思力伝 換効率が増大することが望ましい。 電力転換効 率は入力に対する出力の比(通常はW/W)と 定義され、装置の枢動電圧の導数である。経済 的な枢動回路部品を用いる枢動単圧、すなわち 25ポルトを越えない延圧に際しては、単力伝 換効率は無機袋間の場合 1 × 1 0 W/W 以下に 限定されている。 10 W/W 以上の電力転換効 塞をもつ。厚いフィルム(> 5μπ) または単 結晶を用いる有機エレクトロルミネツセント袋 産が開発されてはいる。しかしそれらの厚さが 比較的大きいため、この誰の毎度を駆動させる のに要する単圧はかなり高い、十なわち100 ボルトせたはそれ以上である。

枢動単圧を25ポルト以下に低下させるため 化は洋錐型エレクトロルミネンセント装置が望 ましい。これはことでは有効な帯域または幅の 厚さ、十なわち電板側にある物質の厚さが 1年元 を観えない装蔵を意味する。ピンホールの問題 を考えると様様の形態を進成することは特に困 継であった。ピンホールは電池をショートさせ

るので受入れられない。たとえばドレスナー・ RCAレビュー、Vod. 30、32211 頁 . (1969年6月)。 特にろ26頁を参振され たい。ピンホールの形成を助止するために、彼 獲用配合物中に統合剤を使用することが軒部合 とされている。この種の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリステレン、および補合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。 単池のショ - トは難けられるが、結合剤を使用することは 不満足な場合がある。とのためには春剤被疫加 工法を用いる必要があり、ある者の軽剤は下槽 の唇剤としても作用する可能性があり、これに より増削の明瞭な境界数定が妨げられる。符合 剤を必要とする 1 者を終剤被優したのち結合剤 を必要としない者(1億または多増)を蒸着さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光暗を容利被覆する場合、母剤が下嵴に影響を 与えた場合の実用性は証明されていない。

米国海許等4.356.429号明細書に記載された電池は、正孔インジェクション管域

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる概をもつ本発明のものと間と便の経緯の一例である。

上記等許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、値まれている電力転換効率。 すなわち 2.5 ポルトを越えない配動電圧を用いた場合化少なくとも 9 × 10 W/W の水準を選 成していない。正孔インジェクション増内のボルフィリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干板収するという値ましくない傾向を示す。またボルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正孔かよび電子の有効な発光的再結合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも1桁改良された。 すなわち少なくとも9×10 W/W 化及ぶ電力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント(以 下*EL*) 密度を提供するととである。

本発明によれば、順次勝柄、正孔インジェクション帝域、有機発光帝域(これらの帝域を令

わせた厚さは 1 #m を越えない)。☆よび降額 からなり。

これらの 電極の りち少なくとも — 方は 4 0 0 nm 以上の被長をもつ權制線の少なくとも 8 0 毛を 遭遇させることができ、かつ

少なくとも 9 × 1 0 W/W の電力伝換効率をも つエレクトロルミネンセント 移職が提供される。

肝ましくはこの後度の発光帯域は、i)2 5 ポルト以下かよび i) この後度の最大電力転換物 本を与える電圧以下で影動される試験を置けて S 動きれる試験を置けて S 動きれる試験を置けて T のクトロルミネッセント 数子効率を与える 電子 で で 化合物からなる。上記試験を置は 1) エニル)ション帯域(この正孔インジェクション帯域(この正孔インジェは) 2 ロの発光帯域を合わせた厚さは 1 μm を終えない)、2) 400 nm 以上の被長をもの郷なよる場所。かよ

びろ」インジウム製強値から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された電力を維効率を示す。

本発明の複数にかいて発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作成され、これ は本発明の実施感様の多くにかいてそれぞれの 帯域に統合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔イン ジェクション層用として、希せられた輻射線に 対し異質的に透過性である化合物が見出された ことである。

本発明の他の有利な特色は続付の図面を考慮 に入れて後記の好きしい実施製機を参照するこ とにより明らかになるであろう。 第1 図は電源 に接続した本発明装置の一部の概略的断面図で あり、

第2回は本発明に従って製造された多数に関する電力転換効率対エレクトロルミネツセント量子効率を示す対数一対数グラフである。

特周昭59-194393(3)

正孔インジェクション由質かよび略光的質は 各帯域内に存在する(この帯域が離であっても 他のものであっても)。 好主しいエレクトロル ミネッセント袋壁にかいてこれらの物質は悪次 糞なった被膜ないしは場中に存在する。

正孔インジェクション場は正孔伝連化合物からなり、一方発光幅は整子伝達化合物からなる。本発明者らは、後記のように駆動かよび構成されるセルに用いた場合に 5×10°光子/電子を越える E L 前子効率を与える特定の電子効率の間には直接的な場合がある。これらの化検効率はよる。これらの化合物を用いるとが保証される。これらの化合物はを合わせた単の形態で洗着するので、有効符成を合わせた単さが1μm を終えない薄膜型を成が容易に得られる。

本発明の多慮に用いられる電子伝導化合物は、 酸化量元反応において過元されりる化合物であ

動電圧をかけ、最大電子転換効率または25 ポルトのいずれかに進するまで(いずれが先に起 とるとしても)高める。この電圧において最大 EL量子効率を創定する。

を | 化は、上記のように構成され、かつ上記の電圧で影響される装置において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関するEL電子効率を示す。 これらの例のそれぞれにつき、最大EL電子効率の電圧は25 ボルトの制限以下であった。

る。本語明にかいて毎代有用なものは、前配の 試験に関して少なくとも 5×10° E L 妻子効率 を与える電子伝達化合物である。最知のように E L 妻子効率は単純に外部回絡で創定される電子/秒に対する、セルから放出される光子/秒 の比に等しい。との効率を成力伝換効率(W/W の単位で定義される)と逸問してはならない。

選子伝達化合物が少なくとも5×10 光子/ 電子(すなわち0.05 %)のEL電子効果を与 えるか否かを判定するためには下記の試験を行

BLセルは下記の職序で構成される:
400nm 以上の故長をもつ報射線の少なくとも80%を透過させる陽板[たとえばネザトロン(Nesatron. 商際) ガラス]: 本質的に1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル) シクロヘキサンからなる正代インジェクション等; 問題の電子伝達化合物の層; およびインジカム製験板。ととで正代インジェクション 優と発光層は合わせて厚さ14を鍵えない。 軽

職団点に対ける	1 8 V	2 0 V	2 0 V	1 5 V	125 V	2 4 V	1 5 V	14 V	
	2×10	1×10	8×10	3×10 ¹	3×10	1.5×10	5×10	8×10.	
400 美	メナトロン製造/メパンドリンギン (1500&1/インシケム(In Ne	(お家宅) ギタトロン部所/HI-1 (75pm)/E1 ・26-11・1・14年	************************************	- 1 2 DM - 1 L T M M M M M M M M M M M M M M M M M M	- 1 nm 1 / 1 ng的 - 4 女子ロン 2 mm / H I - 1 () 2 nm 1 / E 4 / 1 () 2 nm 1 / E 4 / 1 () 2 nm 1 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4 / E 4	・ 2 mm / T n 吸る ・ ・ *** *** *** *** *** *** *** *** **	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 1 2 nm - 1 nmm *女子ロン衛衛/H1 - 1 (1 2 nm) /E7	「 nmm / nmmm

55を徐いて有効数子1個に回拾五入した。

1エビドリジン=

2 H I - 1 = 1,1 - ピス(4 - ジーp - トリ

[44-ヒス[57-ジャーペンナル-2-ペンジャサンリル]ステルペン]

[2,5-ビス[5,7-ジーも・ペンチル-2-ペンゾキサゾリル]チオフェン]

[22-(14-フェレンジピニレン)ピスペングデアゾール]

[2,2'- (4,4'-ピフェニレン) ピスペンゾチアゾール]

7 E5= ピス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

8 E 6 =

9 E7=

[2,5-ピス[5,7-ジーセーベンチルー2-ベンゾキサンリル]-54-ジフェニルチオフエン]

より好ましくは、正化インジェクション順は本質的に無色である。これは陽極に隣接した位成にあり、陽板は透明な電極であることが好ましい。従って正化伝達化合物も400nm 以上の放長にかいて少なくとも90%透過性であることが好ましい。

前記の光透過性をもつ有用な正孔伝達化合物の好ましい例には、室風で間体であり、かつ少なくとも1個の微素原子が微換基でトリ酸換さ

わけではない。有効帯域の一方の層がこの種の 体験形成性化合物である場合、両層にかいて結 合利を称くことができるという点でこの体膜形 成性は有用である。従って本発明の一実施製機 にかいては、発光層かよび正孔インジェクショ ン帯域の双方が結合剤を含有しない。

あるいは他の場合化は正孔と電子の発光的再 総合を妨げない結合剤も本発明化有用である。

制記のように薄膜を形成しうる化合物の有用な例を以下に示す。有に有用な例には複異環もしくは異様、 かよび 5 個以上の数果原子を有する临防族領少なくとも 2 個を含有するか、 あるいは少なくとも 2 個の基すなわちそれぞれ。) 一直結合の関りに可転し うる基かよび。) 少なくとも 3 個の芳香族もしくは飽和炭素濃を含む素を含有する化合物が含まれる。

たとえば柳原形 取性である正孔伝達化合物に は次式の構造をもつものが含まれる。

れた(そのうち少なくとも1個はアリール場または関係アリール基である)アミンが含まれる。アリール基上の有用な関係場の例には、1~5個の炭素原子をもつアルキル基、プテル基かよびアミル基、ハロゲン原子、たとえば塩素原子かよびフッ素原子、ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキン基、たとえばメトキシ基、エトキン場、プロポキシ基、プテル基かよびアミル基である。

本希明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、かよび電子伝達化合物のあるものは、 薄膜形成性化合物であるという付加的な性質をもつことが注目される。ここで用いられるようにある化合物がこの物質を電板などの支持体上に 0.5 μπ 以下の厚さで施した場合に " 薄膜形成性 " である場合、これは 異質的に ビンホールを 含まない 層を形成する。 しかし ある化合物が 薄膜形成性であるということは 分ずしも 0.5 μπ よりも多量に存在しないということを意味する

1, 1 - ピス(4 - ジ - p - トリルアミノフェニル) シクロヘキサン; および次式の構造をもつ 化合物

(上記式中 n は 2 ~ 4 の整畝である)。 たとえば 4 ぎ- ビス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国等 許等4、175.960号明確等13個13行から 14個42行に列挙されたもの。たとえばピス (4-ジメテルアミノー2-メテルフェニル) フェニルメタンかよびN、N、N・トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

部製形成性の電子伝達化合物に関しては、好 ましい例には優先増白剤が含まれる。最も好ま しいものは次式の構造をもつ優先増白剤である。

R*は1~20個の炭素原子を有する飽和脂肪族 残薬、たとえばメナル薬、エナル基かよびn-アイコシル薬: 6~10個の炭素原子を有する アリール薬、たとえばフェニル基かよびナフチ ル薬: カルボギシル薬: 水素原子: シアノ薬: あるいはハログン原子、たとえば塩素原子かよ びフン素原子であり; ただし式c) にかいて R*.R* かよび R*のうち少なくとも 2 個は3~ 10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残蓄。た とえばプロビル等、ブチル等またはヘプテル等 であり、

Zは-0-. -NH-または-S- であり; Yは-R*+CH=CH+R*-.

mは日~4の整数であり;

nd0.1.2±2d3であり;

R* は6~10個の炭素原子を有するアリーレン塩、たとえばフェニレン基かよびナフチレン 基であり;

換された脂肪族機器の場合の整換器には、1~5個の提供服子を有するアルキル基、たとえばメテル基、エテル基かよびプロビル基、たとえばフェニル器かよびナフテル基、ハロゲン原子、たとえば温泉子かよびフッ実原子、ニトロゲンをもびに1~5個の炭素原子を有するアルコキッ基、たとえばメトキッ基、エトキッ基かよびフロポャン基が含まれる。

特に好ましい優先時白朝の例には下記のものが含まれる。2.5 - ピス(5.7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル) - 1.3.4 - チアジアゾール:4.4'-ピス(5.7 - t - ペンチル-2 - ペンゾキサゾリル) ステルペン:2.5 - ピス(5.7 - ジーt - ペンゲキサゾリル) チオフェン:2.2'-(p-フェニレンジピニレン) - ピスペンゾチアゾール:4.4'-ピス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル:2.5 - ピス(5 - (α , α - ジメテルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン:4.4'-

さらに他の有用な優光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637買かよび640買に列挙されている。すでに海膜形成性ではないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合させることによって海膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な優光増白剤には、たとえば下配のものが含まれる。

[2-|2-[4-|2-ペンソイミダンリル] フェニル | ビニル | ペンソイミダソール]

(5-メチル-2-(2-(4-(5-メチル -2-ベンゾキサゾリル)フェニル]ビニル) ベンゾキサゾール]

(2,5 - ヒス(5 - メチル - 2 - ベンゾギサゾ リルリチオフェン]

(2-(2-(4-カルボキシフェニル)ビニル]ベンゾイミダゾール] ⇒よび

(2-[2-(4-クロルフェニル)ビニル] ナフト[1,2-d]オキサゾール]

さらに他の有用な存襲形成性の電子伝達化合物には $8-ヒドロキシャノリンの金属領体が含まれ、その際金属は好ましくは<math>\hat{Z}n$. Ag. Mg または $\hat{L}i$ である。

有効増の一方が檸檬形成性である場合、容易に認められるようにピンホールのため接触がショートすることはないので、他方は檸檬形成性である必要はない。たとえば有用な萎隆は、動配の檸檬形成性化合物からなる正孔インジェクション場、および檸檬形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,5 - ブタジエンからなる発光権を含む。

前記の長しから明らかなように、有用な帰復 選帳には商牒"ネザトロン"のもとにPPGイ

ンダストリーズ社から得られる被覆ガラス降板 が含まれ、有用な帰傷を担任にはインジウムが含 まれる。一般のいかなる増化やよび陰便もそれ が疲切を仕事組数値をもつならば使用できる。 たとえば帰復は悪い仕事関数をもつべきである。 他の有用な場框の例にはいずれかの半透明な高 い仕事関数をもつ事選性材料、たとえば酸化ス メインジウム、世化スズ、ニッケルまたは金で 被獲したガラスが含まれる。好ましくは、との 性の関係は10~1000ォーム/スクエア・ (ohms/square)のシート抵抗、かよび400 nm 以上の放長に対し80mの光透過率をもつ。 とのように高い光透遠宏を少なくとも90まと いり正孔伝達化合物の透過率と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の特色である卓 越した延力伝漢効率が保証される。

他の有用な機能の例には低い仕事類数をもつ 他の金属、たとえば銀、スズ、鉛、マグネンウ ム、マンガンかよびアルミニウムが含まれる。 金属が毎世により発生するルミネッセンスに対 して高い透過事をもつか否かは関係ない。

第1図は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント複数を示す。これは酸化スズインジウムの半透明被模16で被覆されたガラス製支持体14からなる陽低12を含む。この上に正化インジェクション者18が配数される。 18かよび20の一方または双方が薄膜形成性化合物である。 陰極22は標20上に配置され、リードワイヤ24が設置を重要26に接続する。 電源26を入れると陽低12で発生した正孔は層18と20の界面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線hvを発する。

電源26が装置10の最大出力点の電圧たと えば15~25 ボルトで操作される場合、最大 電力転換効率は少なくとも9×10 W/Wである。ある場合にはこの効率が2×10 に及ぶこ とが認められた。本発明の装置は改良された電 力転換効率の結果1700cd/㎡(500フィー

トランベルト)に及ぶ最大輝度を生じることが 認められた。

本発明のBL接触は常弦により作成される。 すなわち正孔インジェクション層、発光磨かよ び陰極をそれぞれ唇液被覆法または蒸発により 施す。正孔インジェクション層が最初に形成されることが好ましい。発光層に有用な唇剤が正 孔インジェグション層に対しても良好な溶剤である場合、発光層を形成するためには蒸発が好ましい。ここで用いられる。蒸発。には蒸気相からのた潜のあらゆる形態が含まれ、真空下で 行われるものも含まれる。

下記の実施例により本格明をさらに設明する。 とれらの実施別にかいて最大輝度は不可逆的破壊を生じる或圧のすぐ下の電圧で創定される。 若干の実施例にかいて収動蔵圧について25V という好ましい限度を越える輝度に関する電圧 が示されているのはこのためである。

奥施例 1

痛1咳のものと類似したエレクトロルミネツ

セント装置(以下"セル")を以下により製造した。

- 1) 陽額を作成するため、ネザトロンガラスをまず 0.05 mm アルミナの研摩材で数分間研摩した、次いでイソプロピルアルコールかよび蒸留水の1:1(M)混合物中で超音放情浄した。次いでこれをイソプロピルアルコールですすぎ、健業で送風乾燥させた。最後に、使用前にこれをトルエン中で超音放情浄し、健業で送風乾燥させた。
- 2) 1,1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)ジクロへキサン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸着法により沈窄させた。すなわち上記物質を電気的に加熱されたタンタル製ポートから320℃の悪変で5×10[©]トルの系内圧力において蒸発させた。ネザトロンガラスに沈着した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。
- 5) 次いで4.4'-ピス(5,7-ジ-t-ベンチル-2-ベングキサゾリル)スチルベン(E1)

を21 K配成したと同じ手法を用いて、ただし 供給課品で350℃を採用してHI-1 増のよ 態化沈着させた。E1層の厚さも75nm であった。

4) 次いでインジウムをE1フィルムの上部化 シャドーマスクを介して沈着させた。In 電傷 の面質はQ1cdであり、これもエレクトロルミ オッセントセルの有効面質を規定した。

出来上がったセルはネザトロンガラス電視をプラスとしてパイアスをかけた場合。 青緑色の光を放出した。放出された光は520 nm K最大放出を有していた。 選成された最大薄壁は与えられた電圧が22Vである場合。 電流密镀140mA/cd Kないて340 ed/m であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は1.4×10⁴ W/W であり、最大エレクトロルミネッセント電子効率は1.2×10⁵ 光子/電子であった。

奥施例2

檸р形成性でない正化インジェクション層の

20 ボルトで駆動した場合、最大電力転換効率 は8.1×10 W/W であり、最大EL電子効 密は6.9×10 光子/電子であった。

これらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジェクション層は薄膜形成性でなくてもよ く、また結合剤を含有しなくてもよいことを歴 引している。

実施例3

発光層用の他の物質

実施的1と同様化してエレクトロルミネンセントセルを設済した。ただし下配の優先増白剤 を発光階として明いた。

(2,5 - ピス(5,7 - ジーも - ペンチル - 2 - ペンゾヰサゾリル1 - 1,34 - チアジアゾール]

使用

突縮例1に記載したようにエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただしN,N,N-トリ(p-トリル)アミンを正孔インジェクツョン幅としてHI-1の代わりに使用した。とのアミンは次式の構造をもつ。

セルは実施例1に記載したものと同じ方法で製造された。ただしアミン蒸発のための供給源温度は120でであった。厚さは75 nm であった。このセルに30 Vをかけた場合、電流密度40 RA/cd かよび最大輝度102 cd/m が得られた。放出された光はこの場合も背景色であり、520 nm に最大放出を有していた。

実施例1と同様にしてセルを製造した。ただし登光増白剤の蒸発のための供給原産では260でであった。放出された光は橙色であり、590nm に最大放出を有していた。得られた最大輝度は30 V かよび40 nA/cdにかいて340cd/㎡であった。20 V で駆動された場合、最大電力転換効率は1.5×10 W/W であり、最大EL電子効率は1.4×10 光子/象子であった。突施例4

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンジビニレン)ビスペンソチアゾール(E3)を発光機として用い、300℃で蒸発させた。

E 3

このセル(オザトロン/HI‐1/E3/In)

は最色の光を放出し、これは560 nm に を大 放出を有していた。 得られた最大輝度は 1.7.5 V シよび 200 nm / cd に かいて 340 cd / nl で あった。 1.5 V で駆動した場合、最大電力伝換 効率は 4×10 W/W であり、最大エレクトロ ルミネッセント量子効率は 3×10 光子/量子 であった。

実施例5

発光槽用の他の物質

前配実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2-(4-ビフェニル)-6-フェニルペンジャサゾール(PBBO)を発光増としてE1の代わりに用い、200℃で蒸発させた。

とのセル(ネザトロン/HI-1/P8BO/In) は白青色の光を放出した。得られた最大輝度は 25Vかよび50mA/ck にかいて34ed/ポで あった。20Vで駆動した場合、最大電力伝染 効率は9.5×10^d W/W であり、最大エレクト ロルミネッセント電子効率は8×10^d 光子/電 子であった。

実施もかよび7

発光増用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし発光着は足1の代わりに2.5 - ビス(5 - (σ . σ - ジメテルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル) チオフエン(実施例6) かよび2.5 - ビス(5.7 - ジーはーペンチル-2 - ペンゾキサブリル) - 3.4 - ジフェニルチオフェンからなり、3.40での温度で蒸発させた。表』に結果を示す。

	おきません。	15V	1 4 V	
歌	操大 因L 能子等報	5×10 ³ 概子/概子	14×10 84×10 W/W RF/EF	
	衛	7×10 W/W	1.4×10 W/W	
	未成	680cd/m² (19V&LO: 150mA/dd K&WT]	1700ed/m² (20V5.LG 300mA/cd K25A7	
	表出	530nm	•	
	6)	€ '	4	
	48	•	~	

実施例8

薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施例1 と同様化 してエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし、1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,3 - ブタジエン(TPB)を発光層として用いた。

TPB昇華のための供給原風度は210℃であった。とのセルは育色の先を放出し、これは450 nm に最大放出を有していた。得られた輝度は20V⇒上び200 mA/d にかいて102 cd/m であった。15Vで駆動した場合、最大電力伝統効率は2×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント世子効率は1.2×10 先子/電子であった。とのセルは蒸発したTPB

特爾昭59-194393(11)

層の不均損なかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB番は顕微硬下で見た場合小さなクラスターのモザイクの外膜を有していた。

実施典9⇒上び10

選子伝達化合物として8-ヒドロキシキノリ人 の金減嫌体を使用

実施例1と同様化してエレクトロルミネツセントセルを設置した。ただしビス(ローヒドロャンキノリノ)アルミニウム(実施例9)、シよび次式

の構造をもつビス(8-ヒドロキシャノリノ)マグネシウムをそれぞれ発光層として用いた。 機作条件は実施例1の記載と同様であった。た だし金属値はの供給製造度はそれぞれ330℃ (実施例9)→よび410℃(実施例10)で あった。表書に結果を示す。

	商業 8 年	15V	2 4 V
	2 #	•	. ~
	4 日本 大口等	5.8×10³ %7/m7	1.5×10* #FAF
	表	82×10	1.4×10*
*	表 解 (fe/q/m)	340 (15V±LO 50mA/al	1247年) 340 (247年10 100mA/cd において)
	数はなる。大人をおれて、なった。のの数での数を	515nm	548nm
	抜な光田でも	螼	*
	800	٥	0,

上配各実施例に示した効率を便宜のため等2 図にプロットした。第2図の点線は傾向を示す にすぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そとに示されたデータは 傾係式

Aog(電力転換効率)= Log(EL量子効率)+Log K (上記式中Kは切片(intercept) であり、 数数電圧化よって一部制御される係数である) 化従うとほぼ直線状である。 数数電圧(項1図の電源26)の値が上がるの化伴って、第2図の曲線は下方へ移動する。 従ってより高い数数 単正では、同一のELサ子効率でも、もはや希望する9×10~W/W の電力転換効率を与えないようになるであろう。

4. [図面の簡単な説明]

明1 図は戦慄に接続した本希明装度の一部の 概略的新面図であり、

第2図は本発明装置に関する電力転換効率対 エレクトロルミネッセント等子効率を示す対数 - 対数グラフである。



